

关键指标

频率: 9~10GHz
 功率增益: 17dB
 输出功率: 41dBm
 功率附加效率: 40%
 二次/三次谐波: -25dBc
 工作电压: Vdd: +28V, Vgg: -2.4V
 产品尺寸: 15.2mm×10.7mm

产品简介

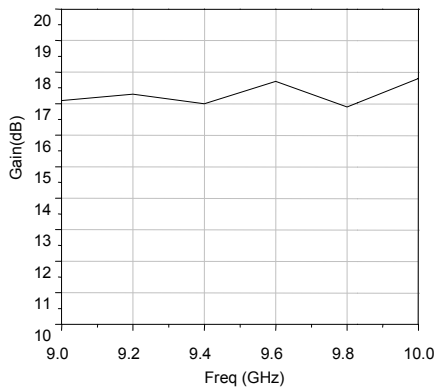
HG535F 是一款 9~10GHz 内匹配功放管, 采用 GaN HEMT 工艺制作, 功率增益为 17dB, 输出功率为 41Bm, 功率附加效率为 40%。

电性能 (栅压-2.7V, 漏压+28V, 静态电流: 50mA, 脉宽 100us, 周期 300us, 33.3% 占空比)

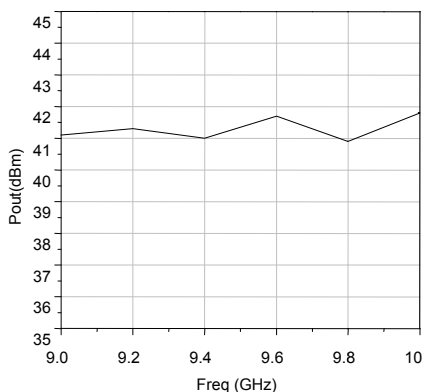
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	9~10		
功率增益(dB)	—	17	—
增益平坦度(dB)	—	±0.5	—
输出功率(dBm)	—	41	—
功率附加效率 (%)	—	40	—
二次/三次谐波 (dBc)	—	-25	—

典型测试曲线

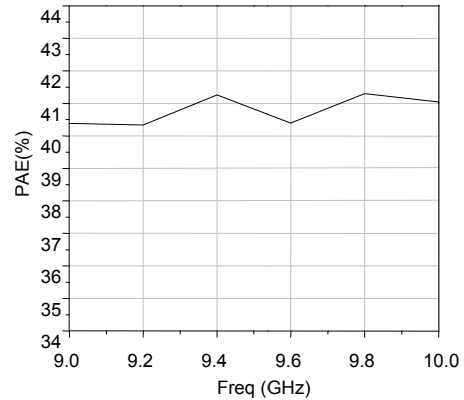
功率增益



输出功率



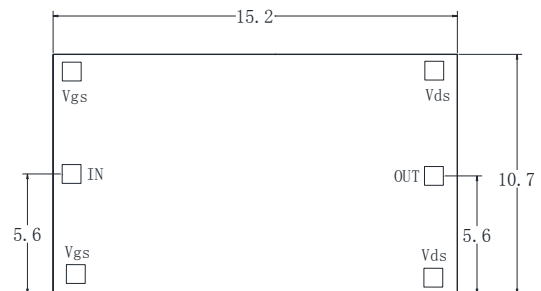
功率附加效率



绝对额定最大值

工作电压	+36V
最大输入功率	+20dBm
工作温度	-55℃~85℃
存储温度	-65℃~150℃

外形和端口尺寸 (mm)



注意事项

1. 功放管在干燥、氮气环境中存储, 在超净环境使用;
2. 功放管管脚硬度低, 外力扭曲容易断裂, 使用时必须小心;
3. 功放管栅极、漏极馈电线需焊接 10uF 去耦电容, 去耦电容耐压值 ≥ 50V;
4. 功放管对静电敏感, 在储存和使用过程。